

а 2015 0001

Изобретение относится к электроизмерительной технике, в частности к газовым сенсорам на основе нанокристаллической пленки из оксида меди легированного серебром.

Газовый сенсор на основе полупроводниковых оксидов, согласно первому варианту для этанола, включает стеклянную подложку, на одной из поверхностей которой осаждена методом химического синтеза из растворов пленка $\text{Cu}_2\text{O}:\text{Ag}$ толщиной 1 μm , которая обрабатывается термически при температуре 650°C в течение 30 мин. Омические контакты осаждены на пленке и выполнены в виде меандра.

Газовый сенсор на основе полупроводниковых оксидов, согласно второму варианту для водорода, включает стеклянную подложку, на одной из поверхностей которой осаждена методом химического синтеза из растворов пленка $\text{Cu}_2\text{O}:\text{Ag}$ толщиной 1 μm , которая обрабатывается термически при температуре 450°C в течение 30 мин. Омические контакты осаждены на пленке и выполнены в виде меандра.

П. формулы: 2

Фиг.: 3